

Промышленные решения



PCIe M.2 SSDs

MTE352T & MTE352T-I

Односторонние твердотельные накопители Transcend MTE352T в форм-факторе M.2 оснащены интерфейсом PCI Express (PCIe) Gen 3 x2 и поддерживают стандарт NVMe Express (NVMe) 1.3, что позволяет им демонстрировать непревзойденный уровень производительности. Твердотельные накопители Transcend MTE352T созданы на базе передовой технологии 3D NAND, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти. По сравнению с накопителями, построенными на базе 3D NAND, которые могут иметь только до 64 слоев, новые устройства отличаются более высокой плотностью записи, а встроенный кэш DRAM обеспечивает более быстрый доступ к хранимым данным. Твердотельные накопители MTE352T изготовлены с использованием технологии угловой заливки и имеют контакты, покрытые золотым напылением толщиной 30 мкм. Накопители проходят тщательное заводское тестирование и выдерживают до трех тысяч циклов записи/стирания, что гарантирует надежность хранения данных. Transcend поставляет накопители MTE352T с расширенным диапазоном рабочих температур от -20°C до 75°C, а также с широким диапазоном рабочих температур от -40°C до 85°C, что обеспечивает стабильность работы в критически важных системах.

Характеристики Оборудования

- Основные компоненты изделия усилены угловой заливкой
- Интерфейс PCIe Gen 3x2
- Гарантированная надежность: память 3000 циклов программирования/стирания
- золотое напыление толщиной 30 мкм
- Расширенный диапазон рабочих температур (-20°C ~ 75°C) и широкий диапазон рабочих температур (-40°C ~ 85°C) доступны

Информация о заказе

128GB	TS128GMTE352T TS128GMTE352T-I
256GB	TS256GMTE352T TS256GMTE352T-I
512GB	TS512GMTE352T TS512GMTE352T-I

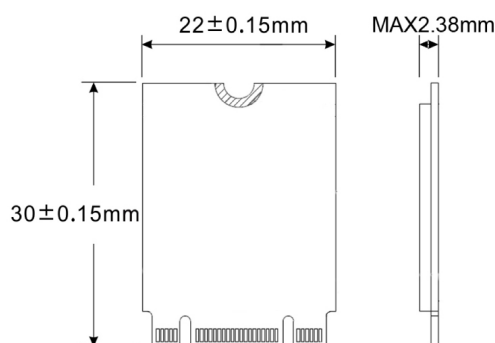
Характеристики Прошивки

- Технология SLC-кэширования
- Поддержка NVMe команд
- Встроенная функция исправления ошибок (LDPC ECC)
- Продвинутый алгоритм сборки мусора
- Динамический термальный троттлинг

Характеристики

Внешний вид	Размеры	30 mm x 22 mm x 2.38 mm (1.18" x 0.87" x 0.08")
	Вес	4 g (0.14 oz)
	Форм-фактор	M.2
	M.2	2230-S3-B-M (Односторонний)
Интерфейс	Интерфейс шины	NVMe PCIe Gen3 x2
Хранилище	Тип Flash памяти	Память типа 3D
	Емкость	128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
Рабочая обстановка	Рабочее напряжение	3.3В±5%
	Рабочая температура	расширенный диапазон рабочих -20°C (-4°F) ~ 75°C (167°F)
		Широкий диапазон -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F)
	Температура хранения	-55°C (-67°F) ~ 85°C (185°F)
	Влажность	5% ~ 95%
	Удар	1500 G, 0.5 ms, 3 оси
	Вибрация (рабочая)	20 G (двойная амплитуда), 7 Hz ~ 2000 Hz (частота)
Питание	Потребляемая мощность (рабочая)	3.12 ватт
	Потребляемая мощность (IDLE)	0.36 ватт
Производительность	Последовательное чтение/запись (CrystalDiskMark, макс.)	Чтение: До 1,700 МБ/с Запись: До 1,000 МБ/с
	4K Произвольное чтение/запись (IOMeter, макс.)	Чтение: До 150,000 IOPS Запись: До 230,000 IOPS
	Среднее время наработки на отказ (MTBF)	3,000,000 час (ов)
	Запись в терабайтах (макс.)	1,080 TBW
	Ресурс перезаписи в день (DWPD)	2.0 (3 года)
Гарантия	Сертификат	CE / FCC / BSMI
	Гарантия	Трехлетняя Ограниченная Гарантия

Механические размеры



Характеристики товара могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленные изображения могут отличаться от реальных. Общая доступная емкость варьируется в зависимости от операционной среды. Из-за сложности и разнообразия промышленных приложений Transcend не может гарантировать полную совместимость со всеми платформами в различных аспектах деятельности. Для применения в специальных приложениях и в уникальных условиях, настоятельно рекомендуется заранее связаться с Transcend для получения разъяснений.